

「輸出貿易管理令の運用について」の一部改正について

「輸出貿易管理令の運用について」（昭和 62 年 1 1 月 6 日付け 62 貿局第 3 2 2 号・輸出  
 注意事項 6 2 第 1 1 号）の一部を下記のように改正し、平成 16 年 1 月 20 日から実施する。

記

1 - 1 の ( 2 ) の ( 八 ) の ( a ) の ( 注 2 ) 中「輸出承認書」を「輸出許可・承認書」に改  
 める。

1 - 1 の ( 2 ) の ( 八 ) の ( a ) の ( 注 2 ) の 中「、大韓民国」を削る。

1 - 1 の ( 7 ) の ( イ ) の次の表 1 の項中

「	軍用の細菌 製剤、化学 製剤若しく は放射性製 剤又はこれ らの散布、 防護、探知 若しくは識 別のための 装置若しく はその部分 品	O - アルキル = アルキルホス ホノフルオリダート ( O - アル キルのアルキル基がシクロ アルキル基であるものを含み 、 O - アルキルのアルキル基 の炭素数が十以下であり、かつ、 アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素 数が三以下であるものに限る。 )、 O - アルキル = N ・ N - ジアルキル = ホスホルアミ ドシアニダート ( O - アルキ ルのアルキル基がシクロアル キル基であるものを含み、 O - アルキルのアルキル基の炭 素数が十以下であり、かつ、 N ・ N - ジアルキルのアルキ ル基の炭素数が三以下である ものに限る。 )、 O - アルキ ル = S - 2 - ジアルキルアミ ノエチル = アルキルホスホノ チオラート ( O - アルキルの アルキル基がシクロアルキル 基であるものを含み、 O - アル キルのアルキル基の炭素数 が十以下であり、かつ、 S - 2 - ジアルキルアミノエチル 及びアルキルホスホノチオラ ートのアルキル基の炭素数が 三以下であるものに限る。 ) 並びにそのアルキル化塩類及 びプロトン化塩類、 S - 2 - ジアルキルアミノエチル = ヒ ドロゲン = アルキルホスホノ チオラート ( S - 2 - ジアル キルアミノエチル及びアルキ	
---	--	--	--

ルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類、2-クロロエチルクロロメチルスルフィド、ビス(2-クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス)、ビス(2-クロロエチルチオ)メタン、1・2-ビス(2-クロロエチルチオ)エタン(別名セスキマスタード)、1・3-ビス(2-クロロエチルチオ)-n-プロパン、1・4-ビス(2-クロロエチルチオ)-n-ブタン、1・5-ビス(2-クロロエチルチオ)-n-ペンタン、ビス(2-クロロエチルチオメチル)エーテル、ビス(2-クロロエチルチオエチル)エーテル(別名O-マスタード)、2-クロロビニルジクロロアルシン(別名ルイサイト1)、ビス(2-クロロビニル)クロロアルシン(別名ルイサイト2)、トリス(2-クロロビニル)アルシン(別名ルイサイト3)、ビス(2-クロロエチル)エチルアミン(別名HN1)、ビス(2-クロロエチル)メチルアミン(別名HN2)、トリス(2-クロロエチル)アミン(別名HN3)を含む。

を  
「

軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤

O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)、O-アルキル=N・N-ジアルキル=ホスホルアミドシアニダート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、

N・N - ジアルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)、O - アルキル = S - 2 - ジアルキルアミノエチル = アルキルホスホノチオラート (O - アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O - アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、S - 2 - ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) 並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類、S - 2 - ジアルキルアミノエチル = ヒドロゲン = アルキルホスホノチオラート (S - 2 - ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) 並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類、2 - クロロエチルクロロメチルスルフィド、ビス(2 - クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス)、ビス(2 - クロロエチルチオ)メタン、1・2 - ビス(2 - クロロエチルチオ)エタン(別名セスキマスタード)、1・3 - ビス(2 - クロロエチルチオ) - n - プロパン、1・4 - ビス(2 - クロロエチルチオ) - n - ブタン、1・5 - ビス(2 - クロロエチルチオ) - n - ペンタン、ビス(2 - クロロエチルチオメチル)エーテル、ビス(2 - クロロエチルチオエチル)エーテル(別名O - マスタード)、2 - クロロビニルジクロロアルシン(別名ルイサイト1)、ビス(2 - クロロビニル)クロロアルシン(別名ルイサイト2)、トリス(2 - クロロビニル)アルシン(別名ルイサイト3)、ビス(2 - クロロエチル)エチルアミン(別名HN1)、ビス(2 - クロロエチル)メチルアミン(別名HN2)、トリス(2 - クロロエチル)アミン(別名HN3)を含む。

に改める。

1 - 1の(7)の(イ)の次の表2の項中

原子炉の部分品	<p>原子炉本体を構成する機器をいい、次のいずれかに該当するものを含む。</p> <p>イ 原子炉圧力容器（上部蓋等の主要部分品を含む。）</p> <p>ロ 原子炉制御棒（中性子吸収部分支持機構及び制御棒案内管を含む。）</p> <p>ハ 原子炉稼働のために特に設計又は製造した内部部分品（炉心保持機構、熱遮へい、バッフル、炉心グリッド板、分散板等を含む。）</p> <p>ニ 原子炉圧力管（50気圧を超える運転圧力下にある原子炉内の一次冷却水と燃料要素を格納するために特に設計又は製造した管）</p> <p>ホ ジルコニウム管（ハフニウムの重量がジルコニウムの重量の500分の1未満のジルコニウム金属又はその合金製のもの）</p>	他の用途に用いることができるものを除く
---------	--	---------------------

を

原子炉の部分品	<p>原子炉本体を構成するために設計又は製造されたものであって、次のいずれかに該当するものをいう。</p> <p>イ 原子炉容器又はその主要部分品（上部蓋を含む。）</p> <p>ロ 原子炉制御棒、中性子吸収部分の支持及び懸架機構、制御棒案内管</p> <p>ハ 炉心板、炉心支持板、炉心支持柱、燃料チャネル、炉心槽、熱遮へい体、炉心バッフル、分散板、シュラウド、シュラウドヘッド、上部格子板、気水分離機、蒸気乾燥機及びその他の内部部分品</p> <p>ニ 原子炉圧力管（50気圧を超える運転圧力下にある原子炉内の一次冷却材と燃料要素を格納するもの。）</p> <p>ホ ジルコニウム管（ハフニウムの重量がジルコニウムの重量の500分の1未満のジルコニウム金属又はその合金製のもの）</p>	
---------	---	--

に改め、

原子炉の附属装置	<p>原子炉本体の外側に据え付けられるものをいい、次のいずれかに該当するものを含む。</p> <p>イ 原子炉への燃料装荷、取り出し機を含む燃料要素取扱い装置</p>	<p>他の用途に用いることができるものを除く。</p> <p>中性子束レベル決定のための放射線検出測定器に内蔵された核燃料物質を除く。</p>
----------	---	---

	<p>ロ 冷却水ポンプ（原子炉一次冷却水を循環させるために特に設計又は製造したもの）</p> <p>ハ 原子炉の出力レベルを制御するための電子制御装置（原子炉制御棒駆動装置及び中性子束レベル決定のための放射線検出測定器を含む。）</p> <p>ニ 熱交換器</p>	
--	--	--

を  
「

原子炉の附属装置	<p>原子炉本体の外側に据え付けるために設計又は製造されたものであって、次のいずれかに該当するものをいう。</p> <p>イ 原子炉への燃料装荷、取出装置</p> <p>ロ 一次冷却材を循環させるポンプ</p> <p>ハ 中性子束レベルを決定するための中性子検出器又は中性子測定器</p> <p>ニ 蒸気発生器又は熱交換器（発生した熱を一次系から二次系へ伝えるために設計又は製造された蒸気発生器又は高速増殖炉の中間熱交換器に限る。非常用炉心冷却系及び崩壊熱冷却系に用いられるものを除く。）</p> <p>ホ 原子炉制御棒駆動機構</p>	
----------	--	--

に改める。

1 - 1の(7)の(イ)の次の表3の2の項中

クロスフロー過	供給液を膜面に沿って流し、透過液が供給液を直角方向に流れる過方法をいう。
---------	--------------------------------------

の次に  
「

滅菌又は殺菌をすることができるもの	<p>物理的手法（例えば、蒸気の使用）あるいは化学物質の使用により当該装置から全ての生きている微生物を除去あるいは当該装置中の潜在的な微生物の伝染能力を破壊することができるものをいう。当該装置中の微生物の量を低減するための洗浄処理のみができるものは含まない。</p>
-------------------	---

を加える。

1 - 1の(7)の(イ)の次の表4の項中

フェロセン誘導体	カトセン、N - ブチルフェロセン及びブタセンを含む。	
----------	-----------------------------	--

の次に  
「

バッチ式の混合機の部	他の用途に用いることができるものを除く。
------------	----------------------

分品		
連続式の混合機の部分品		他の用途に用いることができるものを除く。
ジェットミルの部分品		他の用途に用いることができるものを除く。
金属の粉末の製造用の装置の部分品		他の用途に用いることができるものを除く。

を加え、  
「

噴霧粉又は球形粉	噴霧粉とは溶融金属を飛散させて粉末にしたものをいい、球形粉とは球形の粒子からなる粉末をいう。	
----------	--	--

の次に  
「

複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォームの製造用の装置の部分品若しくは附属品		他の用途に用いることができるものを除く。
---	--	----------------------

を加え、  
「

多次元に、かつ、多軸方向に織ることができる織機又はインターレーシングマシン	複合材料の構造物を製造するため繊維を織り、織り交ぜ又は組むためのものであり、アダプター及び改造キットを含む。	左記の用途のために改造されていない繊維加工機及び2次元 - 2軸織物用のものを除く。
---------------------------------------	--	--

を  
「

三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン	複合材料の構造物を製造するため繊維を織り、編み又は組むためのものであり、アダプター及び改造キットを含む。	左記の用途のために改造されていない繊維加工機を除く。
-------------------------------	--	----------------------------

に改め、

「

レーダー	レーザーレーダーを含む。	
------	--------------	--

」

を削り、

「

寸法の最小値が100ミリメートル以上のもの	100mm × 100mm × 100mm以上の直方体をつくることのできるもの。	
-----------------------	--	--

」

の次に

「

加速度計、ジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置若しくは航法装置の部分品		他の用途に用いることのできるものを除く。
--	--	----------------------

」

を加え、

「

安定性	安定した温度条件の下で計測されたある特定のパラメータについて、その較正值からのバラツキの標準偏差（1シグマ）をいい、時間の関数として表される。	
-----	---	--

」

の次に

「

貨物等省令第3条第十七の三号イ中の部分品		他の用途に用いることのできるものを除く。
飛行制御装置	フライ・バイ・ワイヤー方式を含み、油圧式、機械式、電子光学式、電気機械式のものに限る。	
貨物等省令第3条第十八号の三中の試験装置、校正装置又は心合わせ装置		他の用途に用いることのできるものを除く。
レーダー	レーザーレーダーを含む。	

」

を加える。

1 - 1の(7)の(イ)の次の表5の項中

三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン	複合材料の構造物を製造するため繊維を織り、織り交ぜ又は組むためのものであり、アダプター及び改造キットを含む。ただし、前記の用途のために改造されていない繊維加工機を除く。
-------------------------------	--

を

三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシン	複合材料の構造物を製造するため繊維を織り、編み又は組むためのものであり、アダプター及び改造キットを含む。	左記の用途のために改造されていない繊維加工機を除く。
-------------------------------	--	----------------------------

に改め、

初透磁率	厚さが0.076ミリメートル以上2.54ミリメートル以下の十分に焼鈍した材料を磁束密度及び磁界の強さがゼロの状態において測定したときの値をいう。
------	--

を

初透磁率	初透磁率の測定は、十分に焼鈍した材料にて行わねばならない。
------	-------------------------------

に改める。

1 - 1の(7)の(イ)の次の表6の項中

電子計算機若しくは数値制御装置によって制御されるもの又はあらかじめ記憶させたプログラムを用いて制御されるもの	プローブを用いて測定するものをいう。
--	--------------------

を

電子計算機若しくは数値制御装置によって制御される	プローブを用いて測定するものをいう。
--------------------------	--------------------

座標測定機  
又はあらかじめ記憶させたプログラムを用いて制御される座標測定機

に改め、

測定の不確かさ

信頼率95パーセントで真の値に近似している誤差限界を表す特性値のことをいう。補正不能の系統誤差、バックラッシュ及び偶然誤差が含まれている。(国際規格ISO10360/2参照)

を削る。

1 - 1の(7)の(イ)の次の表7の項中

複合理論性能

8の「複合理論性能」の解釈に同じ。ただし、同解釈中二の(二)の2については適用しない。

及び

位相シフト膜を有する多層マスク

集積回路のパターンの有無にかかわらず位相シフト層を有するすべての多層マスクをいう。

を削る。

1 - 1の(7)の(イ)の次の表8の項中

電子計算機又はその附属装置

電子計算機若しくはその附属装置であって、デジタル暗号処理機能、暗号解析機能、多段階の秘密保護機能(利用者識別機能を含む。)若しくは電磁環境両立性を持つものは、貨物等省令第8条の仕様に照らして貨物等省令第7条第1号八で評価しなければならない。

を

電子計算機又はその附属装置

電子計算機若しくはその附属装置であって、デジタル暗号処理機能、暗号解析機能、多段階の秘密保護機能、利用者識別機能若しくは電磁環境両立性を持つものは、貨物等省令第8条の仕様に照らして貨物等省令第7条第1号八で評価しなければならない。

に改める。

1 - 1の(7)の(イ)の次の表9の項中

信号処理機能

7の「信号処理用」の解釈に同じ。

の次に

「

音声帯域圧縮技術	通信状態により符号化速度が変化するものについては、会話を継続した状態における符号化速度に基づいて判定するものとする。
----------	--

を加える。

別表第1の別紙の1の(6)中「又は大韓民国」を削る。

別表第1の別紙の1の(11)中「又は大韓民国」を削る。

別表第1の別紙の2の(5)中「及び大韓民国」を削る。

別表第1の別紙の2の(15)中「、大韓民国」を削る。

別表第1の別紙の2の(20)中「、以下同じ。」及び「及び大韓民国」を削る。

別表第1の別紙の2の(21)を次のように改める。

(21) 輸出令別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物のうち、貨物等省令第7条第3号八又はホに該当するものであって、輸出令別表第4の2に掲げる地域以外を仕向地とするもの

別表第1の別紙の(注3)の中「「はの 地域とは」の次に「、アフガニスタン」を、「ブルンジ」の次に「、カーボヴェルデ」を加え、「コートジボアール」を「コートジボワール」に改め、「クウェート」の次に「、キルギス」を、「サンマリノ」の次に「、サントメ・プリンシペ」を、「タイ」の次に「、東ティモール」を、「トーゴ」の後に「、トンガ」を加える。